

ЗАКРЕПЛЕНИЕ СОЛИТОНОВ АБРИКОСОВСКИМИ ВИХРЯМИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ДЖОЗЕФСОНОВСКИХ КОНТАКТАХ

Л.Г.Асламазов, Е.В.Гурович

Показано, что в распределенном джозефсоновском контакте наличие абрикосовского вихря в сверхпроводящей пленке приводит к новому типу возмущения синус уравнения Гордона. Такая неоднородность позволяет различать полярность солитонов и приводит к ряду физических эффектов, которые можно наблюдать экспериментально.

В последнее время проявляется большой интерес к исследованию распределенных джозефсоновых контактов (РДК), в которых могут распространяться кванты магнитного потока — солитоны. Для закрепления солитонов в таких контактах используются микрозакоротки¹ и микросопротивления². В настоящей работе рассмотрено влияние на движущиеся солитоны квантов потока, локализованных в сверхпроводнике (например, абрикосовских вихрей (АВ), запиннигованных с помощью искусственно созданных неоднородностей).

Такой способ управления солитонами обладает рядом преимуществ – можно различать полярность солитонов, а также легко создавать и уничтожать управляющие центры.

РДК является одной из многих физических систем достаточно хорошо описываемых синус уравнением Гордона (SG), в котором неоднородности контакта приводят к появлению добавочного члена. В присутствии АВ уравнение на разность фаз параметра порядка φ в сверхпроводниках имеет вид

$$\begin{aligned} \varphi_{tt} - \varphi_{xx} + \sin \varphi = -\alpha \varphi_t - \gamma - \sum_i \eta_i \delta_x (a_i - x) \\ \eta_i = 2\pi e^{-\kappa b_i}, \end{aligned} \quad (1)$$

где координата x , вдоль которой распространяются солитоны, измеряется в единицах джозефсоновской глубины проникновения λ_J , время t измеряется в единицах обратной джозефсоновской плазменной частоты; индексы x и t означают дифференцирование по соответствующим переменным.

Первый член в правой части описывает диссипацию, связанную с протеканием через контакт нормального тока, второй член – однородно распределенный ток (ток смещения); третий член соответствует возмущению, создаваемому АВ, расположенными в сверхпроводнике в точках с координатами a_i на расстояниях b_i от плоскости контакта (оси вихрей перпендикулярны оси x и параллельны плоскости контакта); параметр $\kappa = (\lambda_J/\lambda_L) \gg 1$, где λ_L – лондоновская глубина проникновения.

Возмущение в уравнении SG, вызываемое АВ, обусловлено поверхностными токами, которые приводят к дополнительному градиенту фазы в сверхпроводнике³. Эти токи локализованы в области $\Delta x \sim \lambda_L$, около вихря, размер которой гораздо меньше характерного масштаба изменения фазы λ_J у солитона. Поэтому распределение поверхностных токов можно моделировать δ -функцией, а в уравнении на фазу появляется ее производная. Модифицированное уравнение SG такого вида исследуется впервые.

Физический смысл возмущения становится особенно ясным, если представить уравнение (1) в виде гамильтоновой системы. Тогда в гамильтониане появляется дополнительный член

$$\mathcal{H}^P(\varphi) = \int \eta \delta(a - x) \varphi_x dx = 2\pi \varphi_x(a) e^{-\kappa b}, \quad (2)$$

который в соответствующих единицах совпадает с энергией АВ в магнитном поле солитона в лондоновском приближении.

Для исследования динамики отдельного солитона в РДК при наличии АВ, воспользуемся теорией возмущений, развитой в⁴. Для координаты центра солитона $X(t)$ и его скорости $u(t)$ получаем из уравнения (1) автономную систему обыкновенных дифференциальных уравнений

$$X_t = u + \frac{\eta u}{4} \operatorname{sch}(X/\sqrt{1-u^2}) \left[1 - \frac{X \operatorname{th}(X/\sqrt{1-u^2})}{\sqrt{1-u^2}} \right] \quad (3)$$

$$u_t = \frac{\eta}{4} \sqrt{1-u^2} \operatorname{th}(X/\sqrt{1-u^2}) \operatorname{sch}(X/\sqrt{1-u^2}) + \frac{\pi\gamma}{4} (1-u^2)^{3/2} - \alpha u(1-u^2),$$

где знак η определяется полярностью солитона по отношению к АВ ($\eta > 0$ при одинаковых полярностях), а знак γ – направлением тока смещения.

В простейшем случае отсутствия диссипации и тока смещения ($\alpha = \beta = 0$) система (3) полностью интегрируется. Инфинитные траектории на фазовой плоскости (u, X) определяются формулой

$$X(u) = \pm \sqrt{1-u^2} \operatorname{Ars} \operatorname{ch} \left(\frac{4}{\eta} \left[\left(\frac{1-u^2}{1-u_\infty^2} \right)^{1/2} - 1 \right] \right), \quad (4)$$

где u_∞ — скорость солитона на бесконечности. В случае притяжения солитона к АВ ($\eta < 0$) имеются также предельные циклы, для которых приведем связь скорости в положении равновесия u_{max} и максимального отклонения X_{max} от положения равновесия

$$u_{max}^2 = \frac{\eta}{4} (1 - \operatorname{sch} X_{max}). \quad (5)$$

Как видно из формул (4–5) в зависимости от полярности солитона и его начальной скорости возможны три типа движения: отражение φ^+ -солитона от вихря ($\eta > 0, u_\infty < \sqrt{\eta/2}$), колебания φ^- -солитона около вихря ($\eta < 0, u_\infty = 0$), уход солитонов по другую сторону от вихря (в остальных случаях).

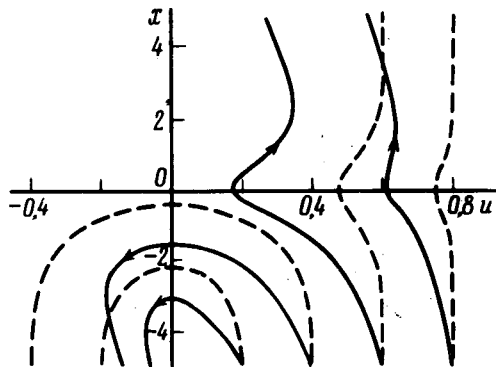


Рис. 1

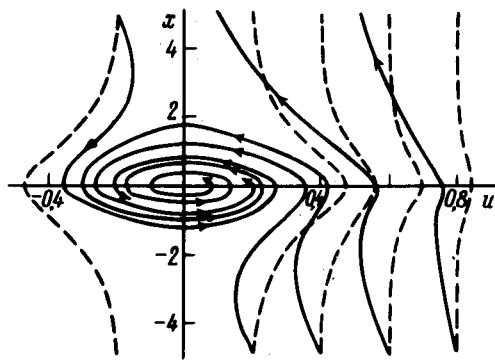


Рис. 2

Рис. 1. Фазовая траектория движения φ^+ -солитона при $\gamma = 0; \alpha = 0; \eta = 0, 4$; (пунктирная линия) и при $\gamma = 0; \alpha = 0,05; \eta = 0,4$ (сплошная линия)

Рис. 2. Фазовая траектория движения φ^- -солитона при $\gamma = 0; \alpha = 0; \eta = 0,4$; (пунктирная линия) и при $\gamma = 0; \alpha = 0,05; \eta = 0,4$ (сплошная линия)

При наличии диссипации и тока смещения система уравнения (3) решается численно на ЭВМ. При этом опять имеется существенное отличие в динамике солитонов разной полярности. На рис. 1 показаны различные фазовые траектории для φ^+ -солитона, а на рис. 2 для φ^- -солитона. Как видно диссипация приводит к закреплению φ^- -солитона, в то время как характер движения φ^+ -солитона существенно не меняется. При наличии тока смещения может также произойти закреплению φ^+ -солитона. Однако, точка закреплению находится вдали от АВ (при малых значениях γ). Координаты X_0 точек закреплению в общем случае находятся из уравнения

$$\frac{\pi \gamma}{\eta} + (\operatorname{th} X_0) (\operatorname{sch} X_0) = 0. \quad (6)$$

Критическое значение тока смещения, при котором закреплению солитонов становится невозможным, $\gamma_c = \eta / 2\pi$.

В гармоническом приближении можно определить частоты колебаний около положения равновесия

$$\Omega^2 = \frac{\eta}{4} \operatorname{sch} X_0 (\operatorname{th}^2 X_0 - \operatorname{sch}^2 X_0). \quad (7)$$

В зависимости от знака η имеются две существенно различные ветви спектра, соответствующие колебаниям φ^+ - и φ^- -солитонов (рис. 3).

Для возбуждения колебаний можно пользоваться импульсом тока смещения, который приводит к появлению у солитона начальной скорости. При этом максимальное отклонение от положения равновесия при отсутствии тока смещения можно рассчитать по формуле (5). Отметим также, что АВ может расщеплять бризеры, распространяющиеся в РДК.

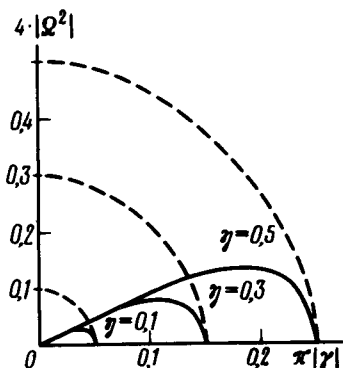


Рис. 3. Зависимость квадрата частоты колебаний Ω^2 φ^- -солитона (пунктирная линия) и φ^+ -солитона (сплошная линия) от значений тока смещения γ при различных значениях η

Все описанные выше эффекты можно обнаружить экспериментально в РДК конечной длины на основе методик, позволяющих регистрировать отражение солитона от концов контакта ⁵, фиксировать момент прохождения солитоном АВ с помощью двух датчиков, расположенных по обе стороны от последнего ⁶ или непосредственно анализировать выходной сигнал на ЭВМ ⁷. При этом необходимо учитывать изменение полярности солитона, которое обычно происходит при отражении от конца линии.

АВ можно закрепить с помощью локального понижения параметра порядка, например, напыляя на сверхпроводящую пленку в определенных местах слой нормального металла (используя эффект близости). Если создать локальное утоньшение пленки и пустить по ней ток, то увеличение плотности тока в этом месте приводит к возмущению тока через контакт также описываемом уравнением (1).

Авторы благодарны А.А.Абрикосову, В.Н.Губанкову, В.А.Кошельцу, А.И.Ларкинжу и А.Т.Филиппову за ценное обсуждение полученных результатов.

Литература

1. Солитоны в действии. М.: Мир, 1981.
2. Гальперн Ю. С., Филиппов А. Т. Письма в ЖЭТФ, 1982, 35, 470.
3. Денисов Ю. П. ФТТ, 1979, 18, 119.
4. McLaughlin D. W., Scott A. C. Appl. Phys. Lett., 1977, 30, 545.
5. Dueholm B., Levring O. A., Mygind J., Pedersen N. F., Soerensen O. H., Cirillo M. Phys. Rev. Lett., 1981, 46, 1299.
6. Scott A. C., Chu F. Y. F., Reble S. A. Journ. Appl. Phys., 1976, 47, 3242.
7. Matsuda A., Kawakami T. Phys. Rev. Lett., 1983, 51, 694.